

(19)  
(12)

(KR)  
(A)

(51) 。 Int. Cl.<sup>7</sup>  
G02F 1/136

(11)  
(43)

2003-0080371  
2003 10 17

(21) 10-2002-0018959  
(22) 2002 04 08

(71) . 20

(72) 1008-1 가-302

104-703

224-1LGLCD 204-726

1510

(74)

:

(54)

， ， ； (active layer) ；  
(ohmic contact layer) ；  
(channel) ；  
) ， ， PR ， ， (poly-imide)  
' 가 ' 가 . ' 가 ' ，

1 .  
 2 4 .  
 3 1 3 .  
 4 3 3 .  
 5 2 3 .  
 6 5 3 .

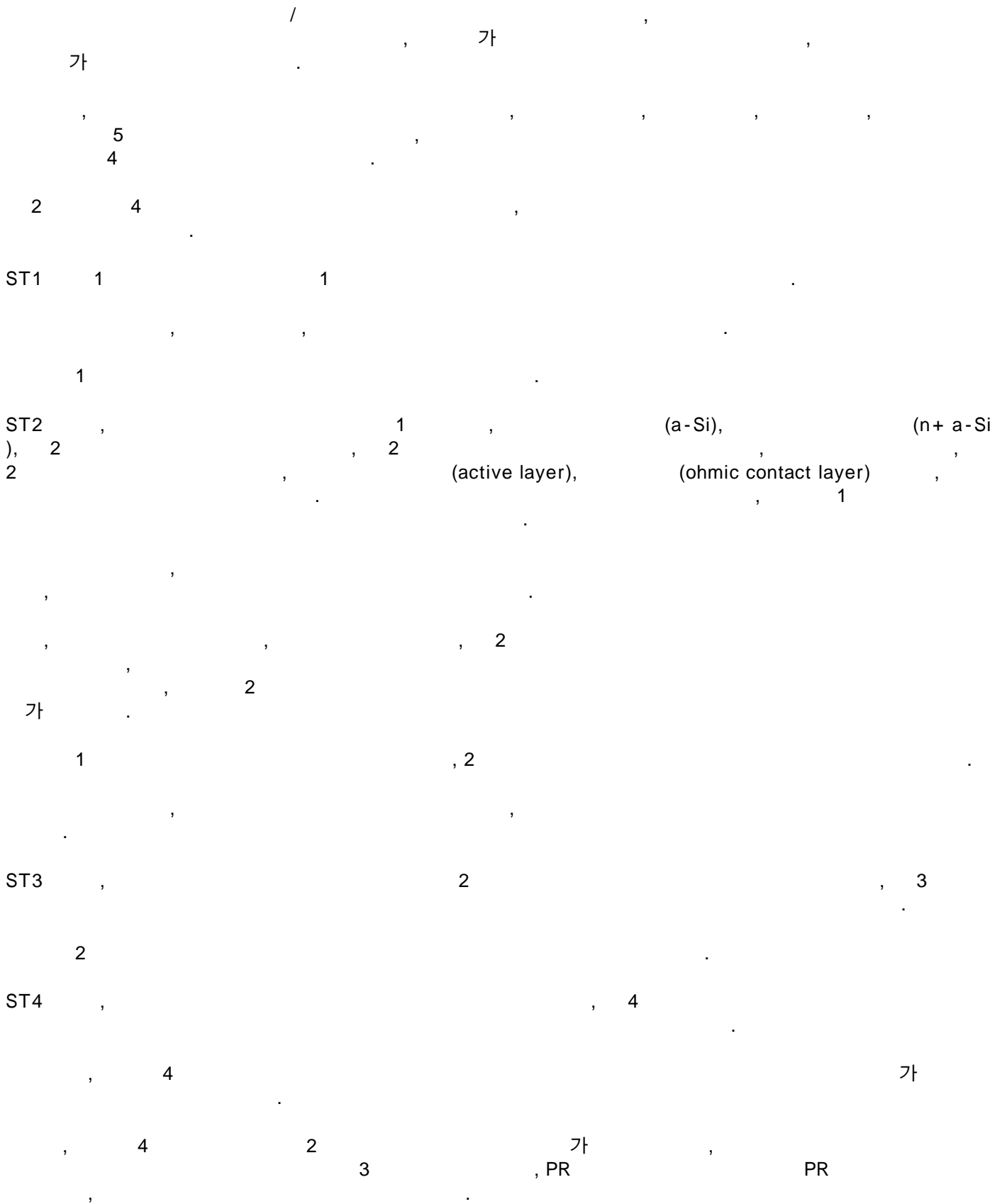
가 가

가

(Thin Film Transistor ; TFT)  
 (Active Matrix LCD : AM-LCD)가

가

1 .  
 ) (50) (10, 30) (10, 30)  
 (32, 34) (30) (T)가 (32, 34) (32, 34)  
 (P) (T) (46)  
 가 (T) 가 (ch ; channe  
 l)  
 (10) (12), (16)  
 (12)  
 ) (10, 30) (52, 54)  
 (54) (back light)가  
 (30) PR(photo resist) , PR 가 , PR  
 PR PR PR PR , PR



가

1)

2)  
method)

(rear exposure

1 ;  
(ohmic contact layer) ;  
(active layer) ;

(channel) ;  
(poly - imide)

2

가

)

(a-Si)

가

1, 2  
(n+ a-Si

1

2

3

1

1

가

2

2

2

3

4

1

1

가

2

2

3

3, 4

3  
(positive type) PR(photo resist)

PR

4  
ve type) PR(photo resist)

PR

(positi

, 3

PR

, 3

(polyimide)

1

, 2

- 1 -

1

( )

3

1

3

ST1

1

, 1

1

가

(positive type) PR

PR

PR

PR

, 1

가

1

(AlNd)/

(Mo)

1 (SiNx)

ST2 2 2

2 가

2 (W), (Cr) (Mo), (Ti), (Ta),

ST3 3 2

4 3 3

(104) (106a) (112) (114) (100) (CH) (102) (104) (108, 110) (112) (102) (104) (106b) (108, 110) (110) (106a)

12) (102), (106), (P) (108, 110) (T) (1

----- 2 -----

2 ( + )

5 2 3 3

ST1 1 1 1

가

1

1

ST2 , 2 , 2

5

가

ST3 , 3

3

가

6 5 3

(200) (202) (202)

(204) (206) (202)

(206) (206) (208, 210)

(208, 210) (210) (212)

(212) (206a) (214) (CH)

(202), (206), (208, 210) (T) (2

12) (P)

3

가

, PR

,  
, 가 ,  
가 .

(57)

1.

;  
;  
(active l  
ayer) ;  
(ohmic contact layer) ;  
;  
(channel) ;  
;  
(poly-imide)

2.

;  
;  
가  
;  
;  
;  
;  
;  
;

3.

2 ,  
가

4.

1 3 ,  
(a-Si) , (n+ a-Si)

1 5. 2 ,

1 6. ,

2 7. ,

8. , , , 1 1 ; ;

가

, 2 , 2 , 2 ; ; 3 ;

9. , , , 1 1 ; ;

가

, 2 2 , ; ; 3 ;

8 10. 9

8 11. 9

9 12. 9

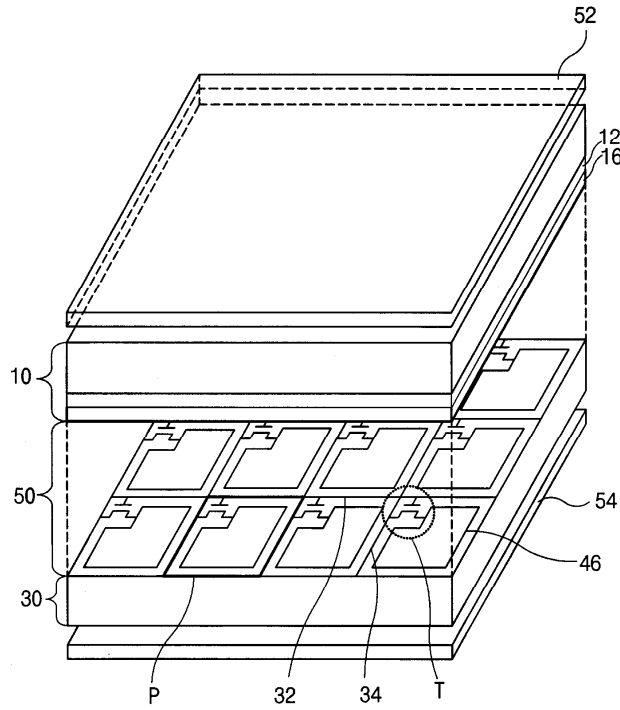
PR

(positive type) PR(photo resist)

PR

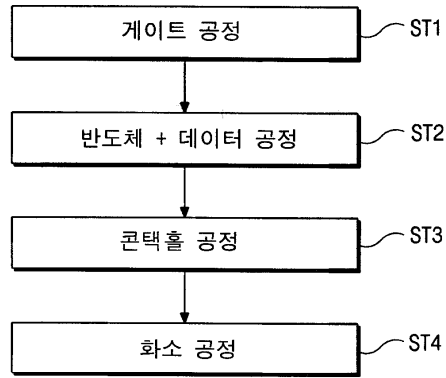
(positive type) PR(photo resist)

1

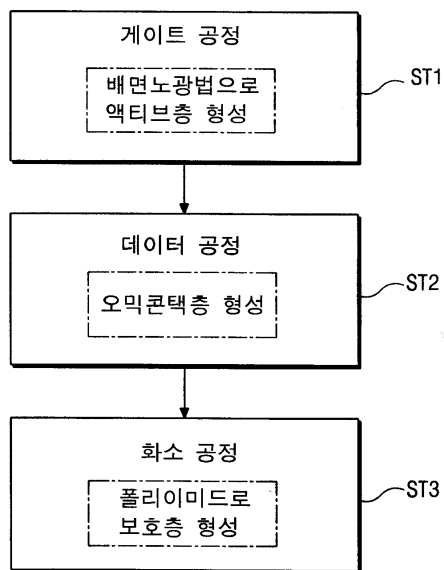


백라이트

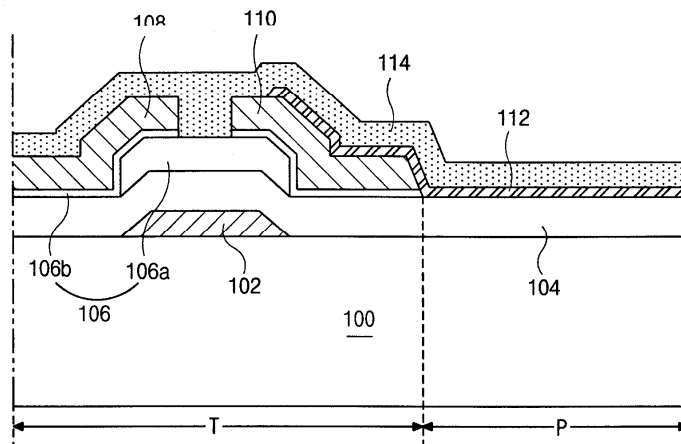
2



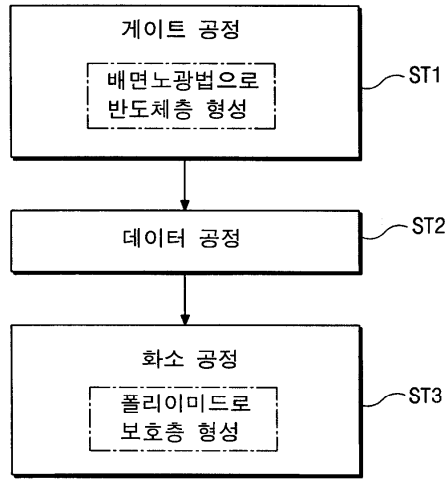
3



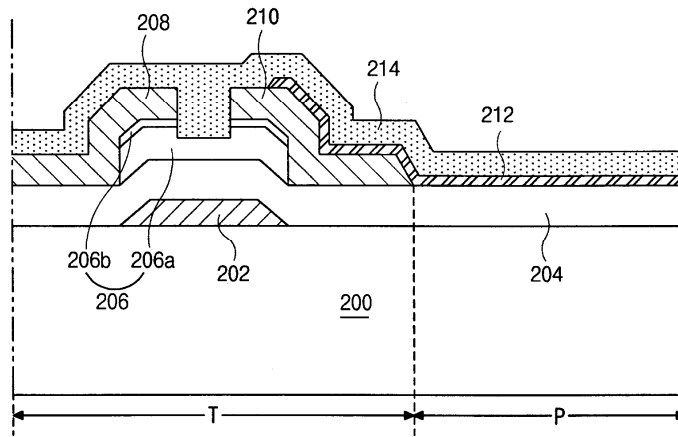
4



5



6



专利名称(译)	用于液晶显示装置的阵列基板及其制造方法		
公开(公告)号	<a href="#">KR1020030080371A</a>	公开(公告)日	2003-10-17
申请号	KR1020020018959	申请日	2002-04-08
[标]申请(专利权)人(译)	乐金显示有限公司		
申请(专利权)人(译)	LG显示器有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	LG显示器有限公司		
[标]发明人	PARK DAELIM 박대림 HWANG SEONGSOO 황성수 KIM YOUNGSIK 김영식 MOON SOOHWAN 문수환		
发明人	박대림 황성수 김영식 문수환		
IPC分类号	G02F1/136		
CPC分类号	G02F1/133723 G02F1/1343 G02F1/136277 G02F1/136286 G02F1/1368 G02F2201/123		
其他公开文献	KR100480331B1		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a>		

摘要(译)

在本发明中，首先可以提高透射率。像素电极直接连接到薄膜晶体管，掩模工艺可以稳定，第三，可以容易地制作PR图案。并且，根据用于液晶显示器的阵列基板的掩模工艺数量的减少，制造成本可以显著降低，所述液晶显示器包括由沟道，与漏电极直接连接的像素电极和聚酰亚胺（聚酰亚胺）组成的保护层。）它形成在覆盖由沟道组成的像素电极的基板顶部区域中，像素电极直接与漏电极连接，并且聚酰亚胺（聚酰亚胺）形成在覆盖像素电极的基板顶部区域中。源极和漏极形成在对应于栅极的位置，它位于栅极绝缘层的上部，对应于形成的有源层的位置：欧姆接触（欧姆接触层）：覆盖有源层和欧姆接触并且以固定间隔彼此分开定位。它具有增加孔径比和存储电容器的优点。

